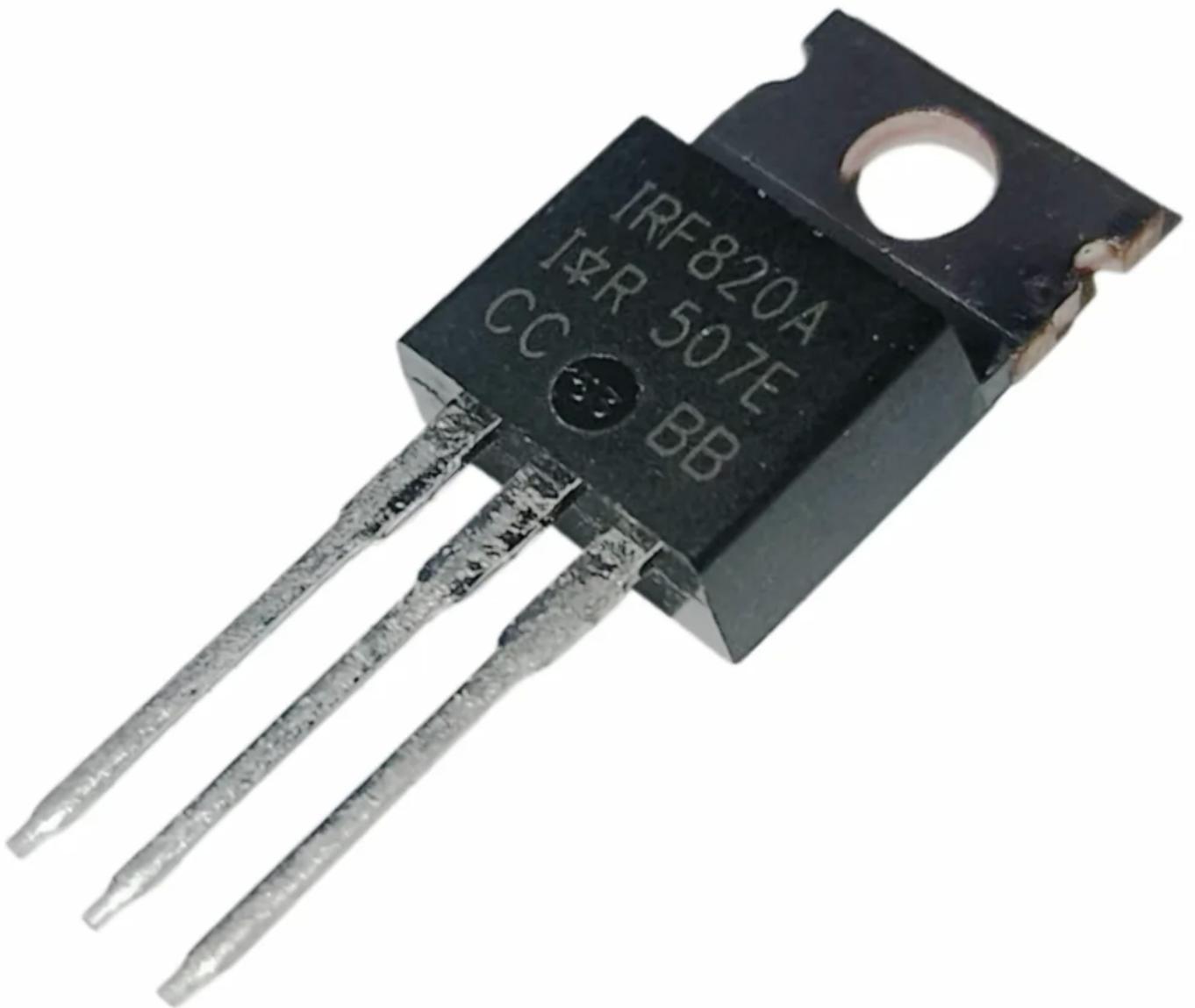




IRF820A: Mosfet N-Ch 500V 50W 2.5A



Descripción

Nombre: MOSFET N-CH 500V 50W 2.5A **Referencia:** IRF820A

- Tipo de FET: MOSFET
- Polaridad de transistor: N
- Pd - Máxima disipación de potencia: 50 W
- |Vds| - Voltaje máximo drenador - fuente: 500 V
- |Vgs| - Voltaje máximo fuente - puerta: 30 V
- |Id| - Corriente continua de drenaje: 2.5 A
- Tj - Temperatura máxima de unión: 150 °C
- Rds(on) - Resistencia estado encendido drenaje a fuente: 30hm

Marca: IR **Empaque:** TO-220 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [IRF820A](#)

Información del producto

Descripción: MOSFET N-CH 500V 2.5W 2.5A. Marca: IR. Referencia: IRF820A El IRF820A es un MOSFET de potencia de canal N diseñado para aplicaciones de conmutación de alta velocidad y alta tensión. Se caracteriza por su baja resistencia en estado encendido y su capacidad para manejar corrientes moderadas, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones.

Precio: \$1.846 IVA INCLUIDO

SKU: 9-10-13

Categorías: [MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

Etiquetas: [0090010000013](#), [9-10-13](#), [datasheet](#), [IR](#), [IRF820A](#), [MOSFET N-CH 500V 2.5W 2.5A](#), [MOSFETS](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#)

